

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-11924

(43) 公開日 平成11年(1999) 1月19日

(51) IntCl.⁵

識別記号

F 1

C 0 1 B 33/02

C 0 1 B 33/02

E

33/037

33/037

C 3 0 B 11/00

C 3 0 B 11/00

21/02

21/02

28/06

28/06

審査請求 未請求 請求項の数15 O L (全 9 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平9-166289

(22) 出願日 平成9年(1997) 6月23日

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 山崎 基治

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

(72) 発明者 奥野 哲啓

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

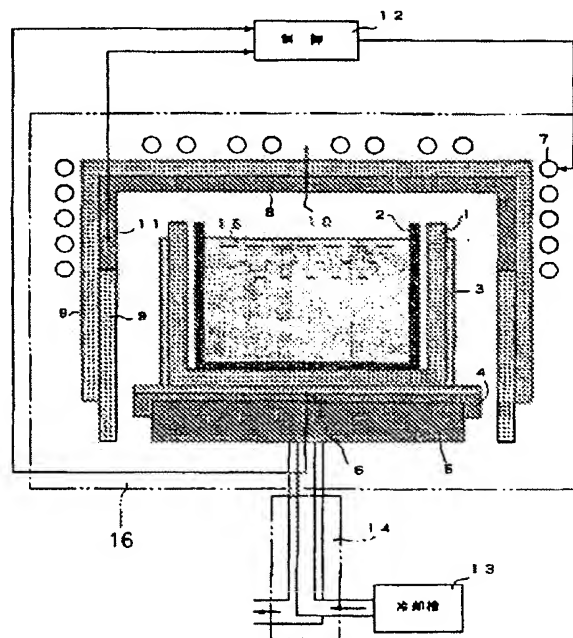
(74) 代理人 弁理士 西教 圭一郎

(54) 【発明の名称】 多結晶半導体インゴットの製造方法および装置

(57) 【要約】

【課題】 一方向凝固で形成する多結晶半導体インゴットの歪みを軽減し、品質を向上させる。

【解決手段】 シリコン半導体材料15は、二重構造のるつぼ1および内側るつぼ2内に装入されて、誘導加熱コイル7によって加熱する発熱体8からの輻射熱で上方から加熱され、融解する。るつぼ1の底部は、冷却槽13からの冷却水で冷却される支持台4に乘載される。内側るつぼ2内で溶融して、底部から凝固が開始される。シリコン半導体材料15は、凝固するときに体積が膨張するけれども、内側るつぼ2とるつぼ1との間には空隙が設けられているので、内側るつぼ2がシリコン半導体材料15とともに外側に拡大すれば、凝固の際の歪みを軽減し、良好な多結晶半導体インゴットを得ることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 固化時に膨張する半導体材料をるつばに装入して、上方から加熱し、下方から冷却することによって、るつば内で半導体材料に下方から上方に向かう一方向凝固を行わせる多結晶半導体インゴットの製造方法において、半導体材料の固化時の膨張による歪みを緩和可能なるつばを用いることを特徴とする多結晶半導体インゴットの製造方法。

【請求項 2】 るつばを二重構造とし、内側のるつばと外側のるつばとの間に空隙を設け、内側のるつばが半導体の膨張に合わせて拡大して、歪みを緩和することを中心とする請求項 1 記載の多結晶半導体インゴットの製造方法。

【請求項 3】 るつばの周壁面よりも内方についてを設け、ついたてを外方に移動可能にしておくことを特徴とする請求項 1 記載の多結晶半導体インゴットの製造方法。

【請求項 4】 るつばは、複数の部分に分割可能で、るつばの各部分は、底面でくし形に組合わされ、径方向の外方に摺動変位可能であることを特徴とする請求項 1 記載の多結晶半導体インゴットの製造方法。

【請求項 5】 前記半導体材料をるつばに装入する前に、るつばの底面に半導体の種結晶を配置し、種結晶から多結晶を成長させることを特徴とする請求項 1～4 のいずれかに記載の多結晶半導体インゴットの製造方法。

【請求項 6】 前記半導体材料は、ポリシリコンであることを特徴とする請求項 1～5 のいずれかに記載に多結晶半導体インゴットの製造方法。

【請求項 7】 内部を不活性な雰囲気中に保ちうる密閉容器と、密閉容器内に配置され、半導体材料を装入するためのるつばと、るつばの上部を加熱して半導体材料を融解させる加熱手段と、るつばの底部を乗載し、回転および昇降変位が可能な支持台と、支持台を冷却する冷却手段とを含み、るつばには、半導体の固化時の膨張による歪みを緩和する歪み緩和手段が備えられることを特徴とする多結晶半導体インゴットの製造装置。

【請求項 8】 前記るつばは、前記歪み緩和手段として、二重構造を有し、二重構造の内側と外側との間に空隙を有することを特徴とする請求項 7 記載の多結晶半導体インゴットの製造装置。

【請求項 9】 前記内側のるつばは、半導体材料よりも高融点で、熔融した半導体材料との濡れ性が悪い金属材料で形成されることを特徴とする請求項 8 記載の多結晶

半導体インゴットの製造装置。

【請求項 10】 前記内側のるつばは、屈曲した形状の周壁を有することを特徴とする請求項 8 または 9 のいずれかに記載の多結晶半導体インゴットの製造装置。

【請求項 11】 前記るつばは、周壁面よりも内方に、外方に移動可能なついたてを有することを特徴とする請求項 7 記載の多結晶半導体インゴットの製造装置。

【請求項 12】 前記るつばと、前記ついたてとの間に、緩衝手段を設けることを特徴とする請求項 11 記載の多結晶半導体インゴットの製造装置。

【請求項 13】 前記緩衝手段は、粒状耐火物であることを特徴とする請求項 12 記載の多結晶半導体インゴットの製造装置。

【請求項 14】 前記るつばは、複数の部分に分割可能で、

るつばの各部分は、底面でくし形に組合わされ、径方向の外方に摺動変位可能であることを特徴とする請求項 7 記載の多結晶半導体インゴットの製造装置。

【請求項 15】 前記るつばの材質は、カーボンであることを特徴とする請求項 14 記載の多結晶半導体インゴットの製造装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、シリコンなどの多結晶半導体インゴットを歪みが少ない状態で製造することができる多結晶半導体製造方法および装置に関する。

【0002】

【従来の技術】シリコンなどの多結晶半導体は、太陽電池の材料などとして、工業生産の面からも資源の面からも注目されている。現在、太陽光発電として実用化されているのは、ほとんどシリコン太陽電池である。しかしながら、まだコスト面で問題があり、将来のエネルギーとしてより広範に使用するためには、より一層のコスト低下を図る必要がある。現在の電力用太陽電池では、単結晶や非晶質シリコンを用いるものが主流である。さらに低コストを実現するためには、多結晶シリコンによる太陽電池の開発が要望されている。

【0003】多結晶シリコン半導体製造の一般的な方法としては、従来からシリカ（酸化珪素： SiO_2 ）などによるるつばに、固体のシリコン材料を装入して、加熱によって一旦溶解した後で、熔融した半導体材料を黒鉛るつばに鋳込んで形成する方法が知られている。たとえば特公昭 57-21515 には、独国ワッカー社から、真空中または不活性ガス中でシリカルるつば内でシリコンを融解し、黒鉛等の鋳型内に入るるつばを傾けて融解したシリコンを注入する半連続鋳造法の先行技術が開示されている。特公昭 58-54115 には、米国クリスタルシステムズ社から、真空中でシリカルるつば内のシリコンを融解し、そのまま凝固させる熱交換法（Heat Exchange Method）の先行技術が開示されている。特開昭 62-2

60710には、ワッカー社の方法の改良として、シリコン融解るつばに水冷した鋼板を用いる先行技術が開示されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】多結晶半導体インゴットの製造では、るつばを用いて結晶を成長させる方法が主流となっている。この方法では、閉込められた空間で半導体の多結晶を成長させる必要があるため、結晶が凝固する際に体積膨張が生じると、凝固した半導体多結晶のるつば内壁との接触部分に応力が発生し、インゴットには応力による歪みが内蔵されたままとなる。インゴットに歪みが内蔵されると、品質低下を招き、半導体としての光学的あるいは電気的な特性が低下し、太陽電池などとして用いる際の発電効率が悪くなってしまう。また応力が大きくなると、機械的な割れなども生じてしまう。

【0005】本発明の目的は、高品質な多結晶半導体インゴットを製造することができる多結晶半導体インゴットの製造方法および装置を提供することである。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明は、固化時に膨張する半導体材料をるつばに装入して、上方から加熱し、下方から冷却することによって、るつば内で半導体材料に下方から上方に向かう一方向凝固を行わせる多結晶半導体インゴットの製造方法において、半導体材料の固化時の膨張による歪みを緩和可能なるつばを用いることを特徴とする多結晶半導体インゴットの製造方法である。

【0007】本発明に従えば、るつばに半導体材料を装入して上方から加熱し、下方から冷却することによって、半導体材料は下方から上方に向かって一方向凝固し、固化時に体積が膨張する。膨張による歪みはるつばによって緩和可能であるので、歪みの少ない高品質な多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0008】また本発明は、るつばを二重構造とし、内側のるつばと外側のるつばとの間に空隙を設け、内側のるつばが半導体の膨張に合わせて拡大して、歪みを緩和することを特徴とする。

【0009】本発明に従えば、二重構造のるつばの内側のるつばと外側のるつばとの間に空隙が設けられ、半導体材料が凝固時に膨張しても、内側のるつばが膨張に合わせて拡大し、歪みを緩和するので、高品質の多結晶半導体インゴットを得ることができる。

【0010】また本発明は、るつばの周壁面よりも内方についたてを設け、ついたてを外方に移動可能にしておくことを特徴とする。

【0011】本発明に従えば、るつばの周壁面よりも内方についたて内で半導体材料を融解し、凝固させることによって、凝固時の体積膨張はついたてが外方に移動して吸収し、応力を緩和して高品質な多結晶半導体インゴットを得ることができる。

【0012】また本発明は、るつばは、複数の部分に分割可能で、るつばの各部分は、底面でくし形に組合わされ、径方向の外方に摺動変位可能であることを特徴とする。

【0013】本発明に従えば、るつばは複数の部分に分割可能で、底面でくし形に組合わされて径方向の外方に摺動変位可能であるので、るつば内部で溶解された半導体材料が凝固する際に膨張しても、るつばの各部分が径方向の外方にそれぞれ摺動変位して歪みを緩和し、高品質の多結晶半導体インゴットを得ることができる。

【0014】また本発明は、前記半導体材料をるつばに装入する前に、るつばの底面に半導体の種結晶を配置し、種結晶から多結晶を成長させることを特徴とする。

【0015】本発明に従えば、多結晶半導体インゴットは、るつばの底面に配置した種結晶から成長させるので、種結晶の加熱時の熱膨張による歪みをるつばによって緩和し、歪みの少ない状態一方向凝固を開始させ、高品質の多結晶半導体インゴットを得ることができる。

【0016】また本発明で前記半導体材料は、ポリシリコンであることを特徴とする。

【0017】本発明に従えば、資源として豊富なシリコンを用いて一方向凝固の多結晶インゴットを高品質な状態で得ることができる。

【0018】さらに本発明は、内部を不活性な雰囲気中に保ちうる密閉容器と、密閉容器内に配置され、半導体材料を装入するためのるつばと、るつばの上部を加熱して半導体材料を融解させる加熱手段と、るつばの底部を乗載し、回転および昇降変位が可能な支持台と、支持台を冷却する冷却手段とを含み、るつばには、半導体の固化時の膨張による歪みを緩和する歪み緩和手段が備えられることを特徴とする多結晶半導体インゴットの製造装置である。

【0019】本発明に従えば、内部を不活性な雰囲気中に保ちうる密閉容器内にるつばを配置し、るつば内に半導体材料を装入して、るつばの上部から加熱し、るつばの底部を冷却して、下方から上方に向かって一方向凝固する多結晶半導体インゴットを得ることができる。半導体の固化時の膨張による歪みは、るつばに備えられる歪み緩和手段によって緩和されるので、歪みの影響の少ない高品質な多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0020】また本発明で前記るつばは、前記歪み緩和手段として、二重構造を有し、二重構造の内側と外側との間に空隙を有することを特徴とする。

【0021】本発明に従えば、二重構造のるつばの内側のるつばと外側のるつばとの間には空隙が設けられるので、内側のるつばが半導体の凝固時の膨張に合わせて変形し、膨張による歪みを緩和して高品質な多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0022】また本発明で前記内側のるつばは、半導体

材料よりも高融点で、熔融した半導体材料との濡れ性が悪い金属材料で形成されることを特徴とする。

【0023】本発明に従えば、内側のるつぼは、半導体材料よりも高融点の金属材料で形成するので、熔融した半導体を貯留し、下方から上方に向けて一方向に凝固させることができる。るつぼの材料は、熔融した半導体材料との濡れ性が悪いので、半導体材料が凝固する際に固液界面付近の熔融した半導体材料を上方に押し上げることができ、凝固時の体積膨張を緩和して高品質の多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0024】また本発明で前記内側のるつぼは、屈曲した形状の周壁を有することを特徴とする。

【0025】本発明に従えば、内側のるつぼ内の半導体材料が凝固時に膨張しても、屈曲した形状の周壁が容易に変形して歪みを緩和し、高品質の多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0026】また本発明で前記るつぼは、周壁面よりも内方に、外方に移動可能なついたてを有することを特徴とする。

【0027】本発明に従えば、ついたて内で半導体材料を融解させ、凝固時の膨張の際についたてが外方に移動可能であるので、膨張による歪みを緩和し、高品質の多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0028】また本発明は、前記るつぼと、前記ついたてとの間に、緩衝手段を設けることを特徴とする。

【0029】本発明に従えば、融解した半導体材料が凝固する際の体積膨張に対し、ついたての移動は緩衝手段によって調整されるので、急激な応力の変化を与えることなく高品質の多結晶半導体インゴットを製造することができる。初期には、種結晶の位置を正確に保つこともできる。

【0030】また本発明で前記緩衝手段は、粒状耐火物であることを特徴とする。

【0031】本発明に従えば、たとえば砂や石英などの粒状耐火物をついたてとるつぼとの間に緩衝手段として配置するので、高温の雰囲気下でも円滑についたての移動に対する調整を行って、半導体の凝固時の体積膨張に対する歪みを緩和して、高品質の多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0032】また本発明で前記るつぼは、複数の部分に分割可能で、るつぼの各部分は、底面でくし形に組合わされ、径方向の外方に摺動変位可能であることを特徴とする。

【0033】本発明に従えば、半導体材料が融解した後、凝固する際にくし形が複数の部分に分かれて半導体の膨張を吸収し、歪みを緩和することができるので、高品質の多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0034】また本発明で前記るつぼの材質は、カーボンであることを特徴とする。本発明に従えば、るつぼの

材料がカーボンであるので、底面のくし形に組合わされている部分が円滑に摺動変位して半導体材料の凝固時の膨張を緩和することができる。

【0035】

【発明の実施の形態】図1は、本発明の実施の一形態である多結晶シリコンインゴット製造装置の概略的な構成を示す。るつぼ1は、大略的に円筒または角筒などの筒状であり、シリカ製である。グラファイト、窒化珪素、窒化ほう素などの耐火物や、タンタル、モリブデンあるいはタングステンなどの高融点金属などから形成される。内側のるつぼ2は、タンタル、モリブデンあるいはタングステンなどの高融点金属で形成することもできる。内側のるつぼ2は、底部が外側のるつぼ1の底面に乗載され、内側のるつぼ2の外周面と外側のるつぼ1の内周面との間には空隙が設けられる。外側のるつぼ1の外周面は、上部を残してグラファイトから成るカバー3で覆われる。外側のるつぼ1の底部は水平な支持台4に乗載される。支持台4は、回転変位可能で、かつ昇降変位可能な台座5に取付けられる。外側のるつぼ1の底面の温度は、熱電対6によって検出される。

【0036】るつぼ1の上方には、間隔をあけて誘導加熱コイル7が配置され、誘導加熱コイル7に高周波電流を流すと、グラファイトやカーボンファイバなどによる発熱体8が誘導加熱される。発熱体8は、るつぼ1の上方に間隔をあけて配置され、発熱体8が加熱されると輻射熱でるつぼ1を上方から加熱する。発熱体8の下方および外側には、グラファイトやカーボンファイバによる熱絶縁体9が設けられる。内側のるつぼ2の内部に対し、上方からパイロメータ10が臨むように取付けられる。発熱体8の温度は、制御用熱電対11によって検出される。熱電対6および制御用熱電対11の出力は、制御装置12に入力され、誘導加熱コイル7による加熱状態が制御される。

【0037】台座5は、冷却層13から供給される冷却水などによって冷却可能である。他の冷媒を用いることもできる。台座5は、駆動手段14によって、るつぼ1の中心を通る鉛直線まわりの回転と、鉛直線方向への昇降変位が可能である。内側のるつぼ2内にシリコン半導体材料15を装入し、誘導加熱コイル7によって内側のるつぼ2上方から加熱すれば、シリコン半導体材料15を上方から底部に向かって融解させることができる。この際に、駆動手段14によって台座5を回転させれば、内側のるつぼ2内のシリコン半導体材料15を均一に加熱して融解させることができる。冷却層13からの冷却水で台座5を冷却すれば、内側のるつぼ2内のシリコン半導体材料15は底部から凝固を開始する。駆動手段14によって、台座5を下降させ、内側のるつぼ2内のシリコン半導体材料15から発熱体8が遠ざかるようにすれば、内側のるつぼ2内の底部から上部に向かう一方凝固を促進することができる。融解しているシリコン半導体材料15

内に、酸素ガスや窒素ガスなどが入り込まないように、装置全体は密閉容器 16 内で外部と密閉され、密閉容器 16 内には真空または不活性ガスなどの不活性な雰囲気

に保たれる。
【0038】図 2 は、図 1 のるつぼ 1 と内側るつぼ 2 とによる二重構造を示す。半導体材料として装入されるシリコンは、1 チャージ当たり 140 kg 程度とする。製造するインゴットは、底面が 55 cm 角となるようにする。前述のように、外側のるつぼ 1 はシリカ（石英）製であり、内側るつぼ 2 はタンタルなどの高融点金属を使用する。内側るつぼ 2 の材料としては、高耐熱性でシリ

コンとの濡れ性が悪いことが好ましい。タンタルのほかにも、最終的に空隙 21 は消失しているけれども、外側のるつぼ 1 には歪みが生じていない。このことから、空隙 21 は、20 mm 以上必要であることがわかる。

【0040】図 3 は、シリコンの融液 15 a が凝固してシリコンのインゴット 15 b になるときに、体積が膨張し、従来のよう

に、周囲のるつぼ 1 で膨張が規制され、インゴット 15 b には応力による歪みが生じる。図 2 に示すように、内側るつぼ 2 がインゴットとともに膨張可能であると、応力を緩和して歪みの影響を軽減させることができる。
【0041】図 4 は、本発明の実施の他の形態として、るつぼ 31 の内側に径方向に移動可能なシリカ製のついたて 32 を配置し、インゴットが固化するときの熱膨張に応じてついたて 32 が移動し、歪みを緩和することができるスライド式を示す。四角柱状のるつぼ 31 の底面には溝 33 が形成され、4 枚のついたて 32 を組み合わせる。各ついたて 32 は、図 5 に示すように側方にかぎ形の凹凸 34 を有する。隣接するついたて 32 で、凹凸 34 同士を組み合わせると、4 枚のついたて 32 は、四角柱状の形状を保ったまま拡大することができる。なお、図 4 に示すような状態

でるつぼ 1 とついたて 32 との間の空隙 35 の間隔は、図 3 と同様に 20 mm とする。図 6 に示すように、ついたて 32 の高さの半分程度まで、空隙には砂や石英粒などの粒状耐火物 36 を入れておく、これによって、初期の固化時に底の大きさを一定に

態の側面断面を示し、図 7 (b) は、組合わされた状態のくし形部 43 を示す。図 7 (a) に示すように種結晶 45 を底面上に敷詰めておけば、半るつぼ 42 a、42 b が離れる方向にくし形部 43 が摺動変位して隙間が大きくなっても、溶融したシリコンが漏れる恐れはなくなる。また、種結晶 45 が重りとしても作用するので、半るつぼ 42 a、42 b の材料として、シリコンよりも比重の小さいカーボンなどを用いることもできる。

【0043】図 1 の実施形態で、多結晶シリコンインゴットを製造する標準的な作業手順としては、図 8 に示すようになる。ステップ a0 から手順を開始し、ステップ a1 では、内側るつぼ 2 内に、ポリシリコンを約 140 kg 挿入して充填する。ここで内側るつぼ 2 は、前述のように底面が 55 cm 角であり、外側のるつぼ 1 との空隙の大きさは 20 mm とする。ステップ a2 ではポリシリコンが充填されたるつぼ 1 を支持台 4 上に置き、その支持台 4 を台座 5 の上に乗せて加熱準備を行う。台座 5 は、冷媒槽 13 からの冷却水によって水冷される。

【0044】ステップ a3 では、誘導加熱コイル 7 に約 7 kHz の周波数の交流電流を流し、誘導加熱を開始し、発熱体 8 の温度を上昇させる。発熱体 8 からの輻射熱によって、るつぼ 1 およびポリシリコンが加熱される。シリコンの融解温度である約 8、420℃以上にならば温度が上昇すると、ポリシリコンは上部から下部に向かって融解が進む。本実施形態では、るつぼ 1 の上側に加熱手段があり、下側に冷却手段がある構造であるので、ポリシリコンは上部から下部に向かって融解する。つぎにステップ a4 では、炉内の温度が一定になるように、誘導加熱コイル 7 に供給する電力を制御して温度制御を行う。ステップ a5 ではパイロメータ 10 によってポリシリコンの融解を確認し、ステップ a6 で内側るつぼ 2 内の温度を徐々に下げながら、同時に台座 5 を降下させ、凝固を開始させる。パイロメータ 10 は、ポリシリコンの表面の放射温度を検出しているけれども、液体と固体とでの放射率の変化も検出する。冷却速度は、たとえば 1℃/h である。降下速度は、10 mm/h で行う。また固化中は、温度分布が生じる影響を低減させるために、1 rpm の速度で台座を回転させる。ステップ a7 では固化が完了しているか否かを、冷却速度の変化などに基いて判断する。固化が完了すると、ステップ a8 で冷却を開始し、冷却が終了するとステップ a9 で製造されたインゴットを取出す。ステップ a9 で手順を終了する。

【0045】図 9 は、インゴットから 125 mm 角のブロックを 16 本取れるようにカッティングする状態を斜線を付して示す。カッティングは、4 辺の切りしろを等間隔にするために行う。図 10 (a) は、切りしろが除去された 16 本のブロックを示す。各ブロックの側面の向きを N、W、S、E とする。図 10 (b) は、図 10 (a) に示す 2 番のブロックについて、S 面における底

部から 100mm の場所でライフタイムを測定するための測定場所を示す。従来のような膨張緩和を考慮していない場合のライフタイム値は 5~7 μ s であるけれども、本発明によればブロックのライフタイム値は 10~15 μ s と高くなっている。なお図 10(a) に斜線を施して示すセンタブロックでの比較では、両方とも 10~15 μ s と同じ値が得られている。

【0046】同様な効果は、二重構造のるつぼの実施形態ばかりでなく、スライド式や、分割式のるつぼでも同様に得られる。また、シリコンとは異なる半導体材料にも同様に適用することができる。

【0047】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、底面から上方に向けて一方凝固させるるつぼが、半導体の固化時の膨張による歪みを緩和可能であるので、歪みの影響を緩和した高品質の多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0048】また本発明によれば、二重構造のるつぼを用いて、半導体の凝固時の膨張による歪みの影響を緩和し、高品質の多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0049】また本発明によれば、ついたての移動によって半導体の凝固時の熱膨張による歪みの影響を緩和し、高品質な多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0050】また本発明によれば、複数の部分に分割されるるつぼを用いて、凝固時の熱膨張の影響を緩和し、高品質な多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0051】また本発明によれば、るつぼの底面に配置した種結晶から上方に向かって一方凝固した、歪みの少ない高品質な多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0052】また本発明によれば、高品質の多結晶シリコンインゴットを製造することができる。

【0053】さらに本発明の製造装置によれば、密閉容器内の雰囲気を不活性な雰囲気によって、支持台でるつぼを回転させながら、加熱手段でるつぼ内に装入した半導体材料を上方から加熱し、冷却手段で支持台を冷却することによって、るつぼ内の下方から上方に向けて半導体材料を一方凝固させることができる。るつぼは、半導体の固化時の膨張による歪みを緩和する歪み緩和手段を備えるので、均質で歪みの少ない、高品質の多結晶半導体インゴットを得ることができる。

【0054】また本発明の製造装置によれば、半導体材料を融解して一方凝固させるるつぼが二重構造を有するので、凝固時の熱膨張の影響を吸収し、歪みの少ない高品質の多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0055】また本発明の製造装置によれば、内側のる

つぼは高融点金属で、融解した半導体材料との濡れ性が悪いので、半導体材料の凝固時の熱膨張による応力歪みを緩和し、高品質な多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0056】また本発明の製造装置によれば、二重構造の内側のるつぼ内で半導体材料が凝固する際に膨張しても、屈曲した形状の周壁が変形して発生する歪みを緩和し、高品質の多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0057】また本発明の製造装置によれば、半導体材料が凝固する際に膨張しても、ついたての移動によって歪みの影響を緩和し、高品質な多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0058】また本発明の製造装置によれば、緩衝手段によって凝固開始時にはついたてが内方寄りの状態を保ち、凝固の進行とともに外方寄りに移動して膨張を緩和させることができる。

【0059】また本発明の製造装置によれば、高温でも円滑についたての移動を行わせることができる。

【0060】また本発明の製造装置によれば、るつぼが分割されて凝固時の膨張による歪みの影響を緩和することができるので、高品質な多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【0061】また本発明の製造装置によれば、底面できし形に組合わされているるつぼの各部分を、円滑に摺動変位させて半導体材料の凝固時の歪みを有効に緩和し、高品質の多結晶半導体インゴットを製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の実施の一形態の概略的な構成を示す簡略化した正面断面図である。

【図 2】図 1 のるつぼ 1 および内側のるつぼ 2 による二重構造を示す簡略化した断面図である。

【図 3】従来のようにるつぼ 1 内で直接シリコンを凝固させるときに、体積膨張によって歪みが発生する状態を示す簡略化した断面図である。

【図 4】本発明の実施の他の形態の概略的な構成を示す断面図である。

【図 5】図 4 のついたて 32 の正面図である。

【図 6】図 5 のるつぼ 31 とついたて 32 との間に、粒状耐火物 36 を緩衝手段として装入する状態を示す簡略化した断面図である。

【図 7】本発明の実施のさらに他の形態のるつぼの簡略化した正面断面図と平面図である。

【図 8】図 1 の実施形態によって多結晶シリコンインゴットを製造する手順を示すフローチャートである。

【図 9】図 1 の実施形態で製造されるシリコンインゴットから 16 個のブロックを切出す状態を示す図である。

【図 10】図 9 に示すようにして切出される 16 個のブロックに番号を付した状態の簡略化した平面図と、第 2

11

12

番目のブロックについてライフタイムを測定する箇所を示す斜視図である。

【符号の説明】

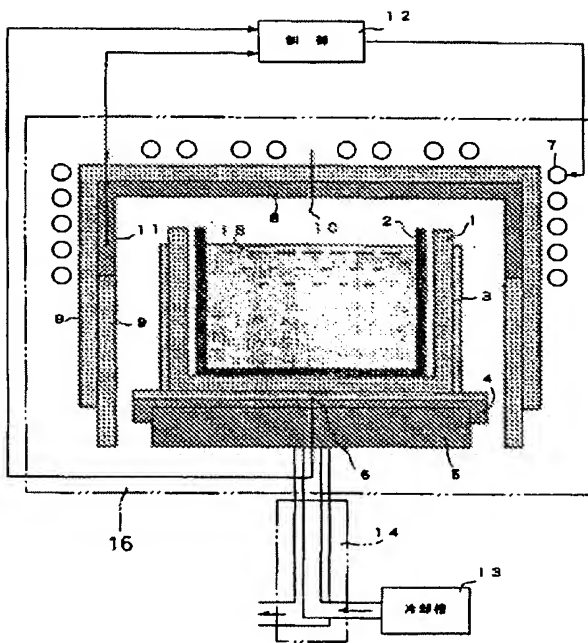
- 1, 31, 41 るつば
- 2 内側るつば
- 4 支持台
- 5 台座
- 7 誘導加熱コイル
- 8 発熱体

* 9 熱絶縁体

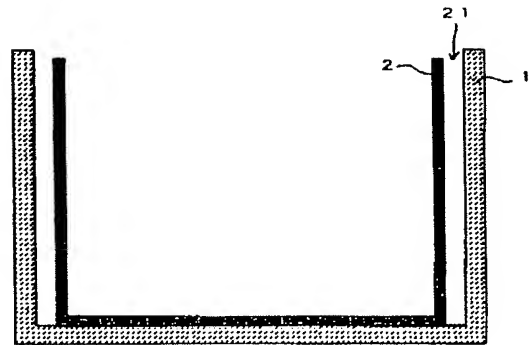
- 15 シリコン半導体材料
- 16 密閉容器
- 21, 35 空隙
- 32 ついたて
- 42a, 42b 半るつば
- 43 くし形部
- 45 種結晶

*

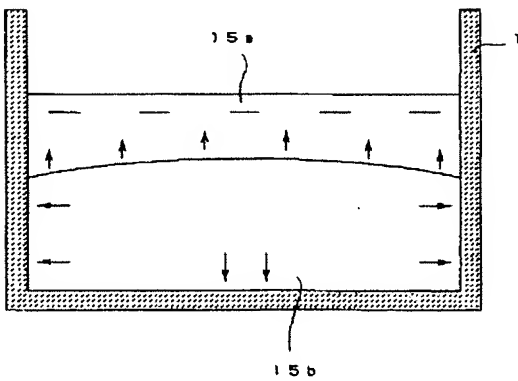
【図1】



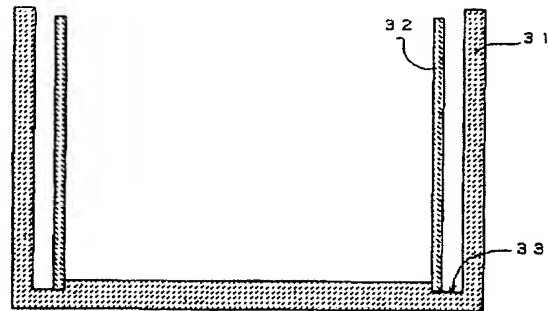
【図2】



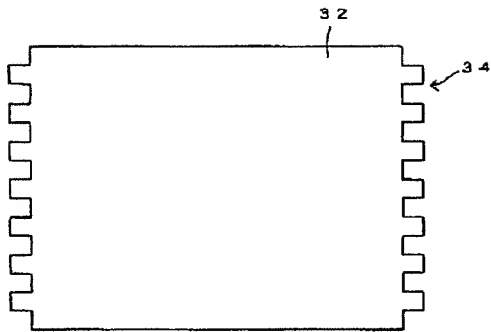
【図3】



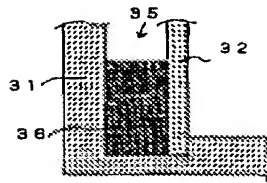
【図4】



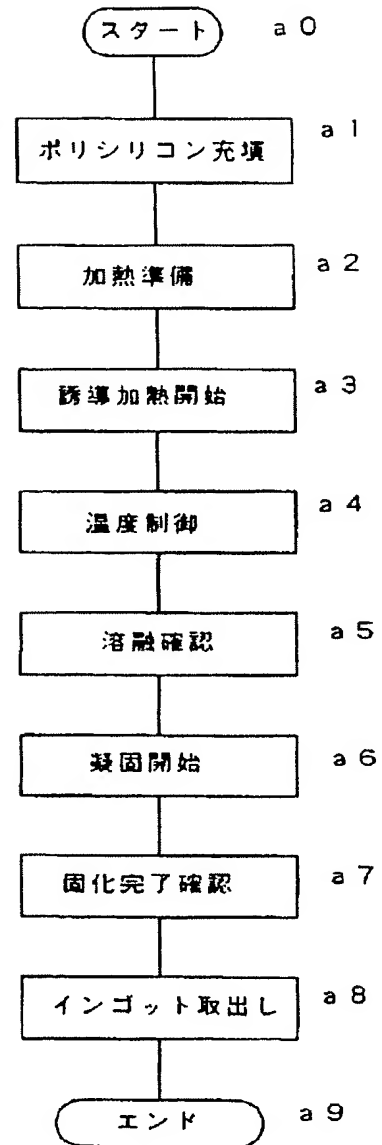
【図5】



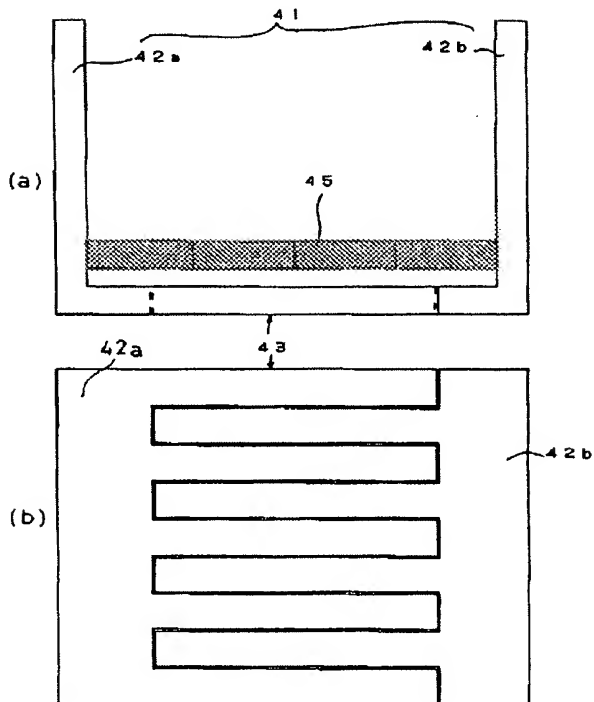
【図6】



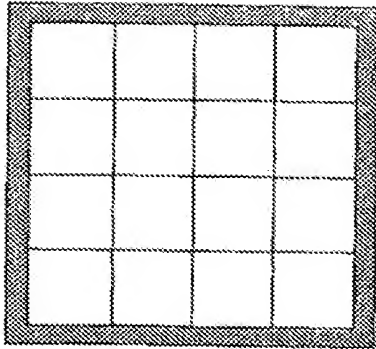
【図8】



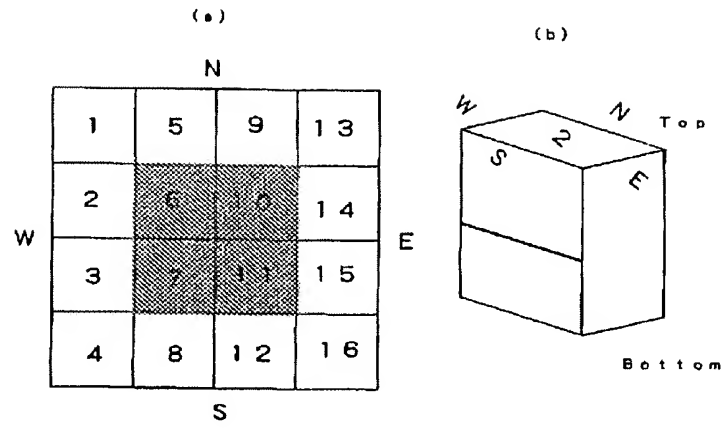
【図7】



【図9】



【図10】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.*

識別記号

C 3 0 B 29/06

H 0 1 L 21/208

// H 0 1 L 31/04

F I

C 3 0 B 29/06

H 0 1 L 21/208

31/04

D

T

H